## 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ

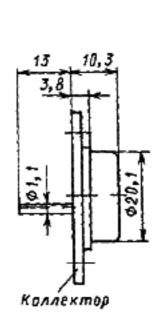
Транзисторы кремниевые меза**шитаксиально-планарные** *п-р-п* универсальные низкочастотные мощ-Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, дифференциальоперационных и ных усилителях, преобразователях в импульсных схемах Транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г выпускаются в властмассовом корпусе с гибкими выводами (вариант 1), транзисторы 2T819A 2Т819Б. 2T819B. KT819AM, KT819EM, KT819BM,

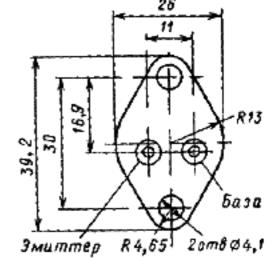
КТ819ГМ — в металлостеклянном

корпусе с жесткими выводами (ва-

Вариант 1 10,65 % 1,37 Ф3,5 % 5 1,15 База 2,8 Коллектор

Вориант 2





КТ819Г не более 2,5 г, транзисторов 2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В КТ819АМ, КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ

риант 2) Обозначе-

вие гипа приводит-

торов КТ819А, КТ819Б, КТ819В,

Масса транзис-

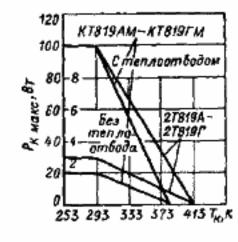
ся на корпусе

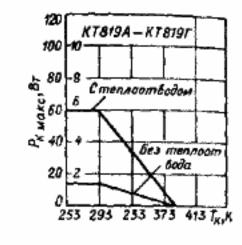
## Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_{\rm K} = 0.1$ A, $\tau_{\rm H} \le 300$ мкс,	
$Q \ge 100$	
КТ819A, КТ819AM не более	25 B
КТ819Б, КТ819БМ, 2Т819В 40-6	a *08~*06
КТ819В, КТ819ВМ, 2Т819Б 60-80	0* - 1004 -
КТ819Г, КТ819ГМ, 2Т819А 80-10	4 +011 - +00
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более	, 110. F
при $I_{\rm K} = 5$ A, $I_{\rm B} = 0.5$ A	
2T819A, 2T819B, 2T819B	ΙB
KT819A, KT819B, KT819B, KT819F, KT819AM,	ı b
КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	2 B
при $I_K = 20$ A, $I_B = 4$ A 2T819A, 2T819B, 2T819B.	5* B
при $I_K = 15$ A, $I_B = 3$ A KT819A, KT819B, KT819B,	
KT819F, KT819AM, KT819BM, KT819BM, KT819FM	
	4° B
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 5$ A,	
$I_{\rm B} = 0.5$ A не более	
2T819A, 2T819B, 2T819B	1,5 B
КТ819A, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ,	<b>.</b> -
<b>КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ</b>	3 B
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим	
эмиттером при $U_{KB} = 5$ B, $I_{K} = 5$ A не менее.	
при $T=298$ K и $T=T_{\rm K}$ макс	
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В	20
KT819A, KT819B, KT819AM, KT819BM	15
КТ819Б, КТ819БМ	20
КТ819Г, КТ819ГМ	12
при $T = 213$ K 2T819A, 2T819Б, 2T819В	9
при T = 233 K	
KT819A, KT819B, KT819AM, KT819BM	10
КТ819Б, КТ819БМ	15
КТ819Г, КТ819ГМ	7
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме	
с общим эмиттером при $U_{K5} = 5$ В, $I_{3} = 0.5$ А	_
o o man open upo o Kg o -, 13	12 ΜΓι
Время выключения* при $I_{\rm K}=5$ A, $I_{\rm B}=0.5$ A не	
более	2,5 мкс
Емкость коллекторного перехода* при $U_{\rm KB} = 5~{ m B}$	
Emports Resident opinion of the organization o	1000 пФ
Пробивное напряжение коллектор-база при $T =$	.037
$= 213 - 298$ K, $I_{\kappa} = 1$ MA H npu $T = 398$ K,	
$I_{K} = 5$ mA не менее	
2T819A	100 B
	80 B
2Т819Б	60 B
2T819B	(A) D
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 40$ В не более	
КТ819A, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ,	
КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	[ мА
прн $T = 233 - 298$ К	[ MA

## Предельные эксплуатационные данные

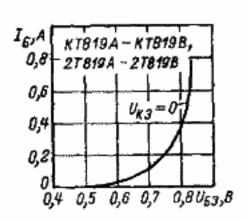
Постоянное напряжение коллектор-база	
2T819A	25 B
2Т819Б	40 B
2T819B	60 B
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при	
$R_{\rm E3} \le 100$ OM, $T = T_{\rm MHH} - 323$ K	
KT819A, KT819AM	40 B
КТ819Б, КТ819БМ	50 B
KT819B, KT819BM	70 B
2T819A, KT819Γ KT819ΓM	100 B
2Т819Б	80 B
2T819B	60 B
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 B
Постоянный ток коллектора	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	10 A
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ,	
KT819BM, KT819ΓM	15 A
Импульсный ток коллектора при $\tau_{\rm H} \le 10$ мс, $Q \ge 100$	
КТ819A, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	15 A
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ,	
KT819BM, KT819ΓM	20 A
Постоянный ток базы	3 A
Импульеный ток базы при $\tau_{\rm w} \le 10$ мс, $Q \ge 100$	5 A
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
с теплоотводом при $T_{\kappa} \le 298$ K	
КТ819A, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	60 Вт
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В, КТ819АМ, КТ819БМ,	
КТ819ВМ, КТ819ГМ	100 B <sub>T</sub>
без теплоотвода при Т ≤ 298 К	
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г	1,5 <b>B</b> T
Tempo de la companya della companya	2 Вт
2Т819А, КТ819Б, 2Т819В	3 BT
Температура перехода	_
2Т819А, 2Т819Б, 2Т819В	423 K
КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г, КТ819АМ,	<del></del>
КТ819БМ, КТ819ВМ, КТ819ГМ	398 K

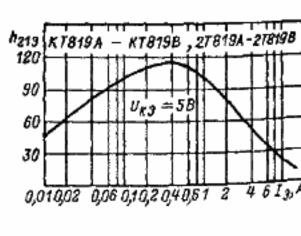




Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.





Входная характернстика.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.